

# КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е, КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* мало-  
мощные

Предназначены для работы в усилительных и импульсных  
микромодулях и блоках герметизированной аппаратуры

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами  
в двух вариантах

Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,3 г

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

при  $T = 298 - 373$  К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В . . . . .	15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е . . . . .	30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К . . . . .	45 В
КТ209Л, КТ209М . . . . .	60 В

при  $T = 228$  К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В . . . . .	10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е . . . . .	25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К . . . . .	40 В
КТ209Л, КТ209М . . . . .	55 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{БЭ} \leq 10$  кОм

при  $T = 298 - 373$  К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В . . . . .	15 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е . . . . .	30 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К . . . . .	45 В
КТ209Л, КТ209М . . . . .	60 В

при  $T = 228$  К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В . . . . .	10 В
КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е . . . . .	25 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К . . . . .	40 В
КТ209Л, КТ209М . . . . .	55 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:

при  $T = 298 - 373$  К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е . . . . .	10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М . . . . .	20 В

при  $T = 228$  К:

КТ209А, КТ209Б, КТ209В, КТ209Г, КТ209Д, КТ209Е . . . . .	10 В
КТ209Ж, КТ209И, КТ209К, КТ209Л, КТ209М . . . . .	15 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 300 мА

Импульсный ток коллектора . . . . . 500 мА

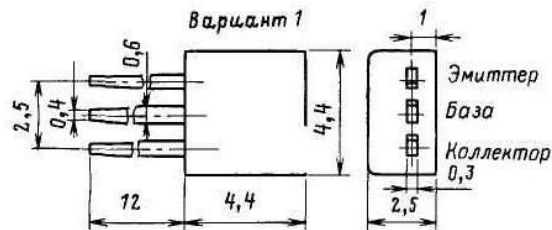
Постоянный ток базы . . . . . 100 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора . . . . . 200 мВт

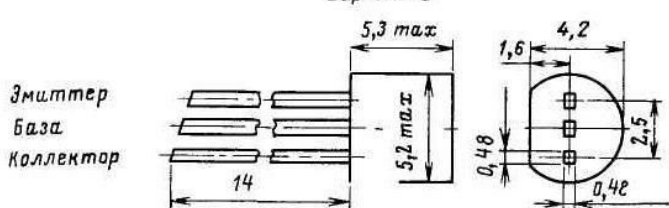
Тепловое сопротивление переход-среда . . . . . 0,45 К/мВт

Температура перехода . . . . . 398 К

Температура окружающей среды . . . . . От 228 до 373 К



Вариант 2



## Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_K = 10$ мА не менее . . . . .	5 МГц
Коэффициент шума при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_K = 0,2$ мА, $f = 1$ кГц, $R_T = 3$ кОм КТ209В, КТ209Е, КТ209К не более . . . . .	5 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 1$ В, $I_K = 30$ мА при $T = 298$ К	
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . .	20-60
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М . . . . .	40-120
КТ209В, КТ209Е . . . . .	80-240
КТ209К . . . . .	80-160
при $T = 373$ К	
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . .	20-120
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М . . . . .	40-240
КТ209В, КТ209Е . . . . .	80-480
КТ209К . . . . .	80-320
при $T = 228$ К	
КТ209А, КТ209Г, КТ209Ж, КТ209Л . . . . .	10-60
КТ209Б, КТ209Д, КТ209И, КТ209М . . . . .	20-120
КТ209В, КТ209Е . . . . .	40-240
КТ209К . . . . .	40-160
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 300$ мА, $I_B = 30$ мА не более . . . . .	0,4 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 300$ мА, $I_B = 30$ мА не более . . . . .	1,5 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 500$ кГц не более . . . . .	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 1$ МГц не более . . . . .	100 пФ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером* при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_K = 5$ мА . . . . .	130-2500 Ом
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = U_{ЭБ\max}$ не более . . . . .	1 мкА